

OMRON

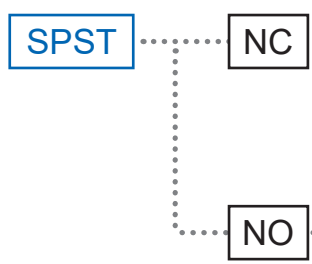
丰富的产品系列
提供多种封装、接点构成及功能供您选择!



G3VM

MOS FET继电器
MOS FET继电器模组

MOS FET继电器 产品选型



MOS FET继电器

组合使用LED/PDA/MOS-FET, 实现继电器功能

在绝缘的同时传递信号! 灯泡点亮

① 电流流经 LED 进行发光, ② PDA(太阳能电池) 发电, ③ MOS-FET 为 ON。

带低漏电流功能的 MOS FET继电器模组

漏电流 I_{LEAK} vs 施加电压 V_{DD}

G3VM-21MT 测量电路示例



带1c切换功能的 MOS FET继电器模组

MOS FET继电器模组 SPDT接点构成型

SPDT构成电路

与有接点继电器的对比

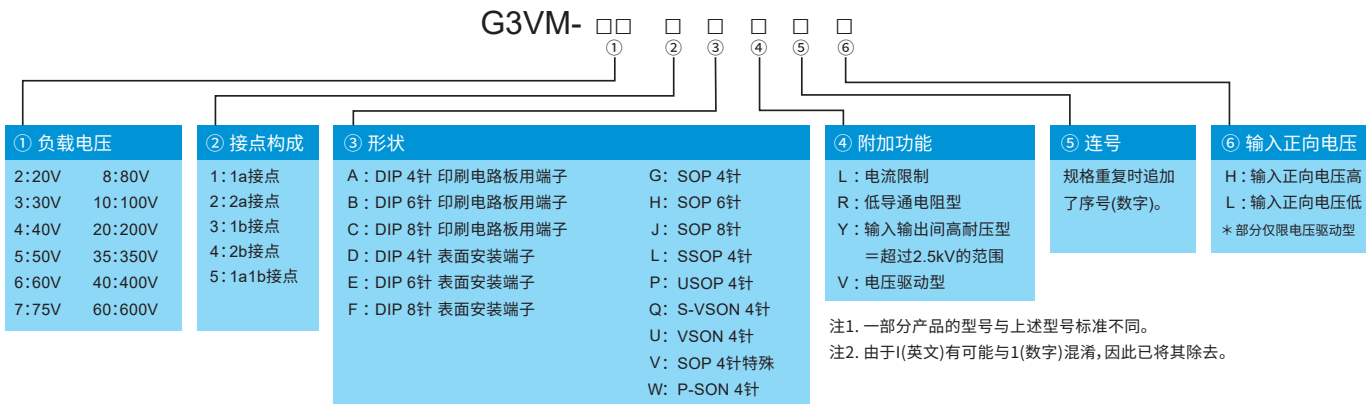
模组详情请参阅P3

	干簧继电器	机械继电器	T模组 G3VM-□1MT	SPDT模组 G3VM-□M	MOS FET继电器 G3VM-□□□
接触可靠性 (ON电阻)	△	△	◎	◎	◎
耐久性	○	△	◎	◎	◎
漏电流	◎	◎	◎	△	△
隔离	◎	◎	◎	×	×
接点构成(SPDT)	◎	◎	-	◎	-

MOS FET继电器 型号、包装、封装标准

MOS FET继电器

MOS FET继电器 型号标准



MOS FET继电器 包装种类

通用封装

封装种类	A DIP4 通孔	B DIP6 通孔	C DIP8 通孔	D DIP4 表面安装	E DIP6 表面安装	F DIP8 表面安装	G SOP4 表面安装	V SOP4 (特殊) 表面安装	H SOP6 表面安装	J SOP8 表面安装
卷盘包装				TR:1500个 TR05:500个	TR:1500个	TR:1500个	TR:2500个 TR05:500个	TR:3000个 TR05:500个	TR:2500个 TR05:500个	TR:2500个
杆状包装	100个/根	50个/根	50个/根	100个/根	50个/根	50个/根	100个/根	125个/根	75个/根	50个/根

小型封装(带防湿包装)

封装种类	L SSOP 表面安装	M P-SON 表面安装	P USOP 表面安装	U VSON 表面安装	Q S-VSON 表面安装
卷盘包装	TR05:500个	TR05:500个	TR05:500个	TR05:500个	TR05:500个
杆状包装					

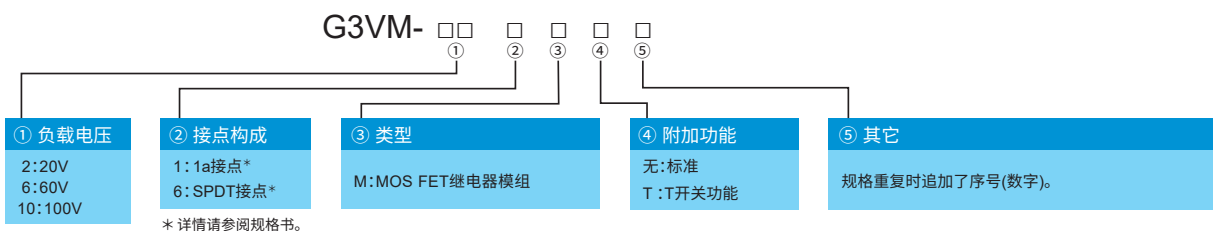
注1. 无杆状包装的封装也可按卷切形式小批量交付。
 注2. 通孔型无卷盘包装品。
 注3. 卷切品非防湿包装,因此无法进行回流焊安装(自动封装)。

封装种类

DIP 假设封装面积为100% 	SOP 封装面积62% 	SSOP 封装面积24% 	USOP 封装面积20% 	P-SON 封装面积19% 	VSON(R) 封装面积10% 	VSON 封装面积9% 	S-VSON 封装面积8% *相对于VSON为84%
-------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---

MOS FET 继电器模组 型号标准

MOS FET 继电器模组



PICK UP MOS FET 继电器模组 SPDT接点构成型

MOS FET继电器
SPDT模组

采用欧姆龙独特技术^{*}, 实现了可在电路板上省面积地轻松构建SPDT接点结构的半导体继电器模组。



G3VM-26M10 (低C_{OFF}机型)

适合高频(≤300MHz)的信号切换

G3VM-26M11 (低R_{ON}机型)

支持大电流(≤1A)的开关

G3VM-66M (通用机型)

60V 0.4A的输出侧额定, 适用于广泛用途

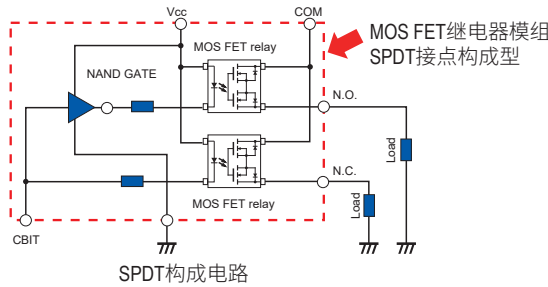
适合替代有接点继电器^{*}
* 干簧继电器、机械继电器等

* 2021年 本公司调查结果

特点 1 减少工时

- 课题** 使用半导体继电器构成SPDT接点时, 需要复杂的电路和多个部件
- 解决** 通过整装化减少电路设计和部件选型的工时

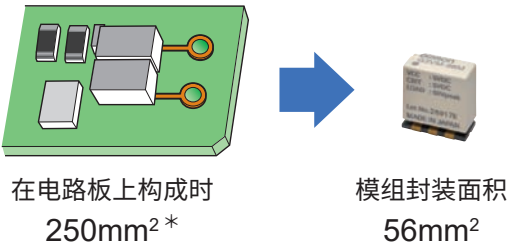
将构成SPDT接点所需的一整套复杂电路模组化。可实现电路板设计的高效化和高密度封装。



特点 2 空间 五分之一

- 课题** 使用半导体继电器构成SPDT接点时, 需要的电路板空间大
- 解决** 采用独特封装技术^{*}的省面积结构可减少封装空间

与在电路板上构成SPDT电路相比, 节省空间78%。



* 2021年 本公司调查结果

特点 3 长寿命

- 课题** 现有SPDT有接点继电器(干簧继电器、机械继电器等)的接点寿命有限, 需定期维护
- 解决** 通过半导体继电器化实现了长寿命, 可降低定期维护的频率

基于半导体的无接点结构, 无电弧放电。不会发生机械性磨损故障。



SPDT模组 产品系列

SPDT模组											
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入额定电压 (V)	输入输出间耐压 (Vrms)
20	G3VM-26M10	6	SPDT	200	4.4	2	1	0.3	0.3	5	500
20	G3VM-26M11	6	SPDT	1000	0.21	2	40	2.5	1.5	5	500
60	G3VM-66M	6	SPDT	400	1	2	20	1	1	5	500

PICK UP

MOS FET继电器模组 T模组型

将3个MOS FET继电器组合而成的“T型电路结构”整装化，实现漏电流极小化。有助于提高半导体试验装置等的测量精度。



- G3VM-21MT(高隔离型)
- G3VM-61MT(大电流型)
- G3VM-101MT(高电压型)

适合替代有接点继电器*

* 干簧继电器、机械继电器等

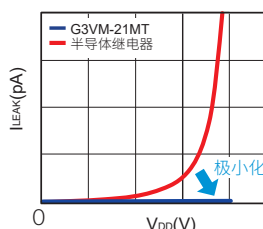
特点 1 提高测量精度

课题 半导体继电器有漏电流，微小电流测量精度降低

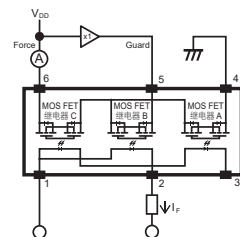
解决 采用T型电路结构，实现漏电流1pA以下可测量微小电流

实效值0.1pA以下，将对计测仪器精度的影响控制在较低限度。

漏电流 I_{LEAK} vs 施加电压 V_{DD}



G3VM-21MT 测量电路示例



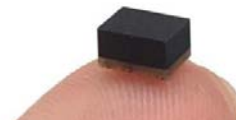
特点 2 省空间化

课题 有接点继电器的尺寸大，需要的电路板空间大

解决 欧姆龙超小型外形尺寸，实现省空间化

搭载复杂电路的同时实现小尺寸，有助于设备的高密度化。

欧姆龙超小型外形尺寸
5mm × 3.75mm × 2.7mm



特点 3 长寿命

课题 现有有接点继电器(干簧继电器、机械继电器等)的接点寿命有限，需定期维护

解决 通过半导体继电器化实现了长寿命，可降低定期维护的频率

基于半导体的无接点结构，无电弧放电。不会发生机械性磨损故障。



无物理接点，
不会发生接点摩擦故障

T模组 产品系列

T模组

负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(pA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)
20	G3VM-21MT	6	1a*	200	8	1	0.6	0.3	0.3	500
60	G3VM-61MT	6	1a*	Io Main : 800 Io Sub : 400	0.4	1	38	2.5	0.5	500
100	G3VM-101MT	6	1a*	550	0.8	1	23	2.5	0.5	500

* 详情请确认产品规格书“●动作模式”

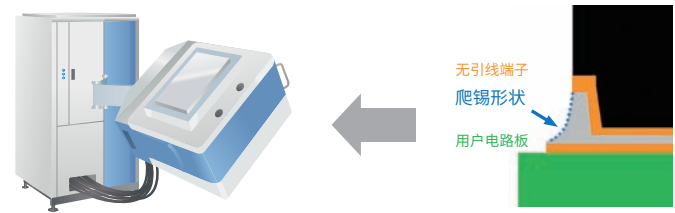
MOS FET继电器 产品选型

推荐用于半导体检查装置

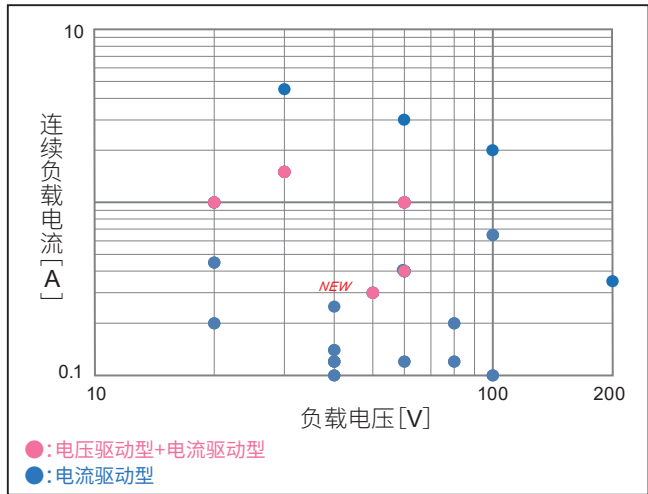
假设DIP封装面积为100%时

P-SON 封装面积 19% 	VSON(R) 封装面积 10% 	VSON 封装面积 9% 	S-VSON 封装面积 8% * 相对于VSON为84%
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

推荐使用兼顾高密度封装和特性的MOS FET继电器
使用方便的500个/卷小型封装规格
可润湿侧翼结构



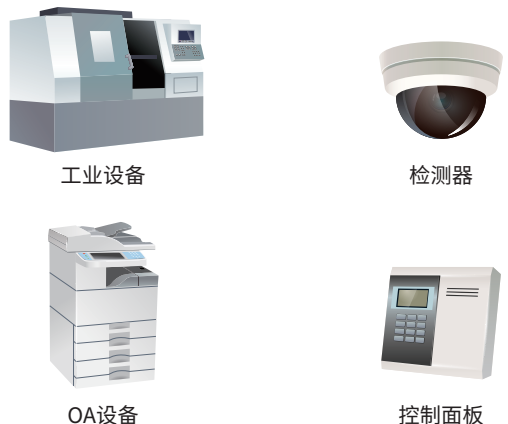
形成爬锡, 封装强度提高, 封装后的焊接可视性优异



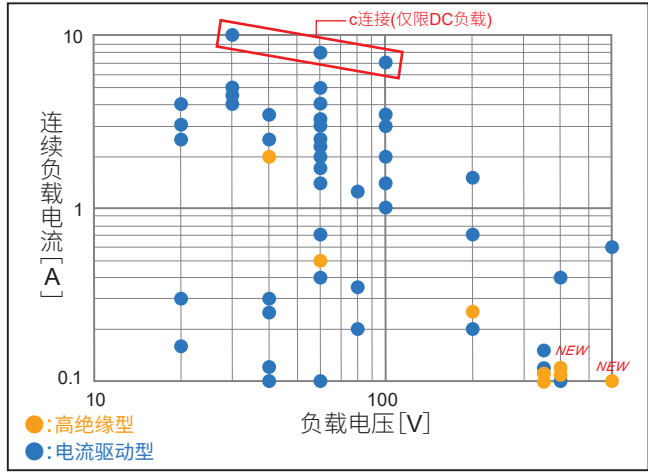
通用(FA, OA, Alarm, Communication)

DIP 假设封装面积为100% 	SOP 封装面积 62% 	SSOP 封装面积 24% 	USOP 封装面积 20%
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

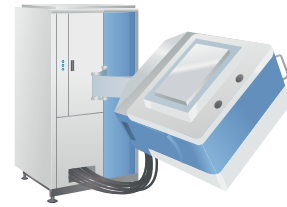
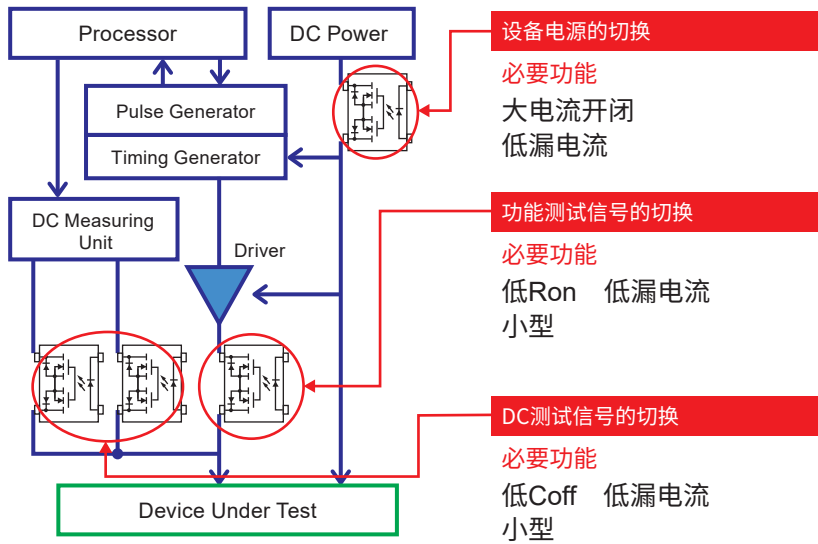
以FA设备为主的多种用途推荐使用MOS FET继电器
* 拥有众多UL认证产品。



提供1b接点型号, 有助于降低常时通电时的耗电量。

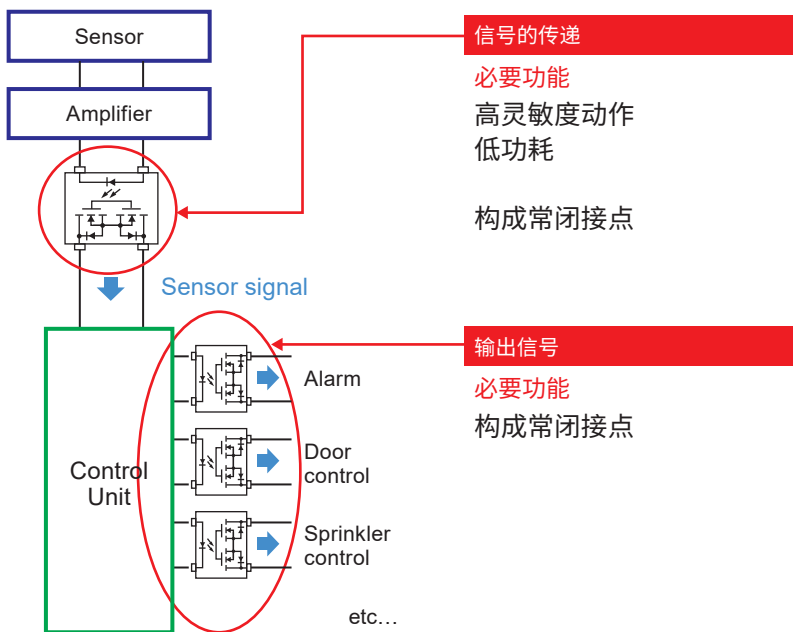


半导体检查装置的电路示例



● □ SON封装系列 etc.

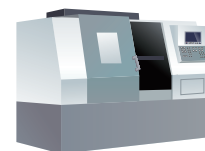
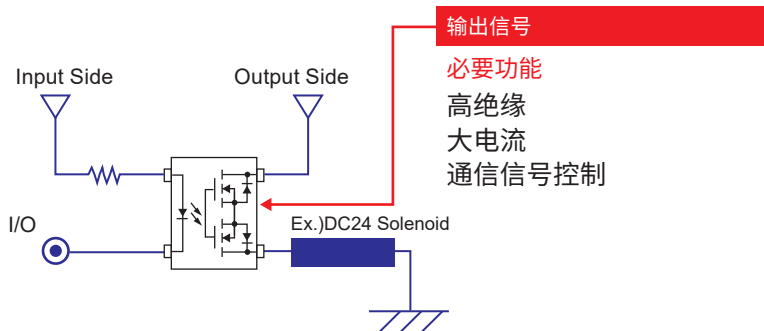
传感器的电路示例



● 高灵敏度型
● 常闭型(1b)

● 常闭型(1b)

FA设备的电路示例



● 高绝缘型
● 大容量型
● 通用型

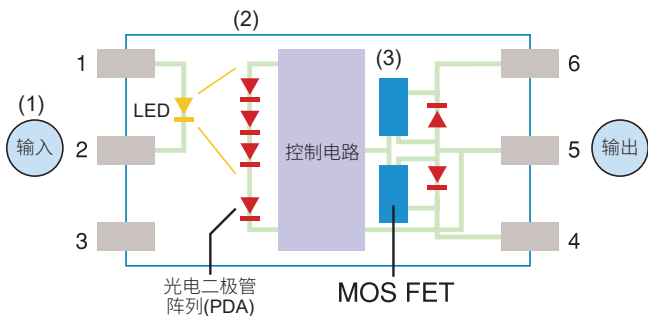
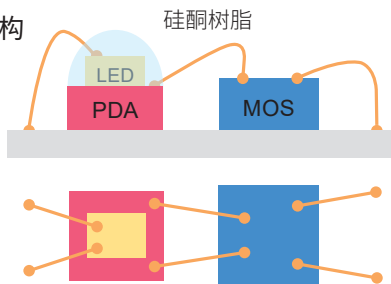
MOS FET继电器

MOS FET继电器是指输出元件采用了MOS FET的光半导体器件,正在积极推进用于机械式继电器的替代。优良的性能将客户的烦恼一扫而空。

例) VSON



内部结构
电路图

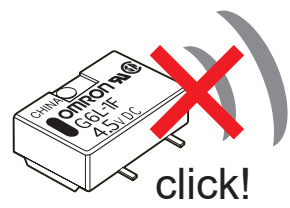


1. 电流流入输入侧, LED发光。
2. 输出侧的PDA受光后转换为电压。
3. 该电压变为MOS FET的触发电压来驱动MOS FET。

特点 1 静音

课题 想消除现有有接点继电器(干簧继电器、机械继电器等)的工作噪音
解决 使用无机机械接点的MOS FET继电器,实现静音动作

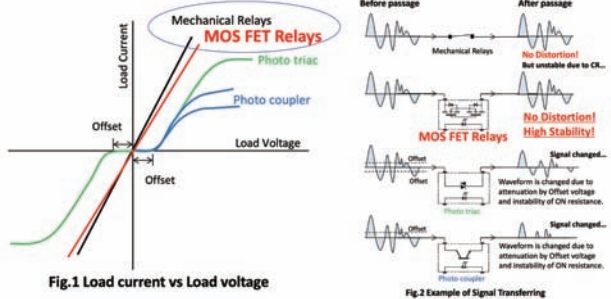
机械继电器在ON动作时接点会发出触碰的声音,由无机机械接点的半导体构成的MOS FET继电器则没有触碰的声音。



特点 2 优异的线性特性

课题 使用光电晶体管、光电三端双向开关时,输出侧信号会发生畸变
解决 使用MOS FET继电器抑制输出侧信号的畸变

光电晶体管、光电三端双向开关的输出侧元件的线性差,通过输出间的信号会发生畸变,MOS FET继电器凭借优异的线性特性可抑制信号的畸变。



特点 3 长寿命

课题 现有有接点继电器(干簧继电器、机械继电器等)的接点寿命有限,需定期维护
解决 通过半导体继电器化实现了长寿命,可降低定期维护的频率

基于半导体的无接点结构,无电弧放电。不会发生机械性磨损故障。



新产品简介 “P-SON”

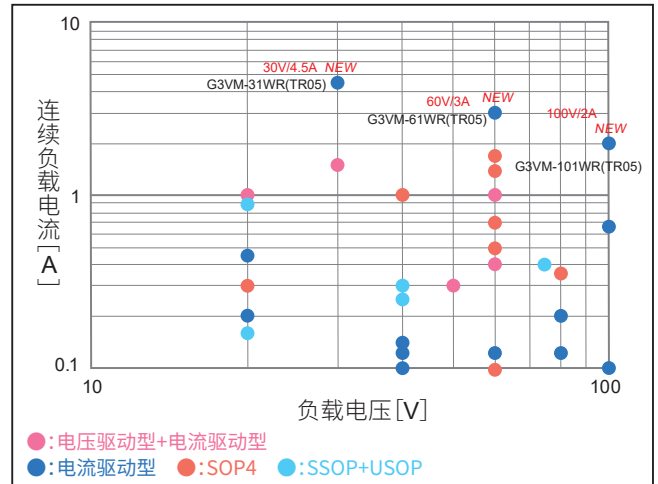
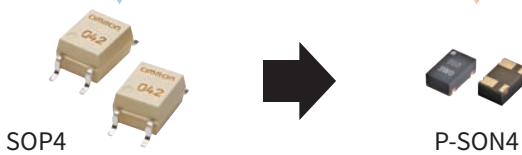
新发布了尺寸比SOP4小但可实现大电流通电的P-SON系列。
同时提供两种价值,“小型”和“高电流”。

封装	型号规格	接点	负载电压(V)	连续负载电流(A)
P-SON4	G3VM-31WR	1a	30	4.5
P-SON4	G3VM-61WR	1a	60	3
P-SON4	G3VM-101WR	1a	100	2
P-SON4	G3VM-201WR	1a	200	0.35

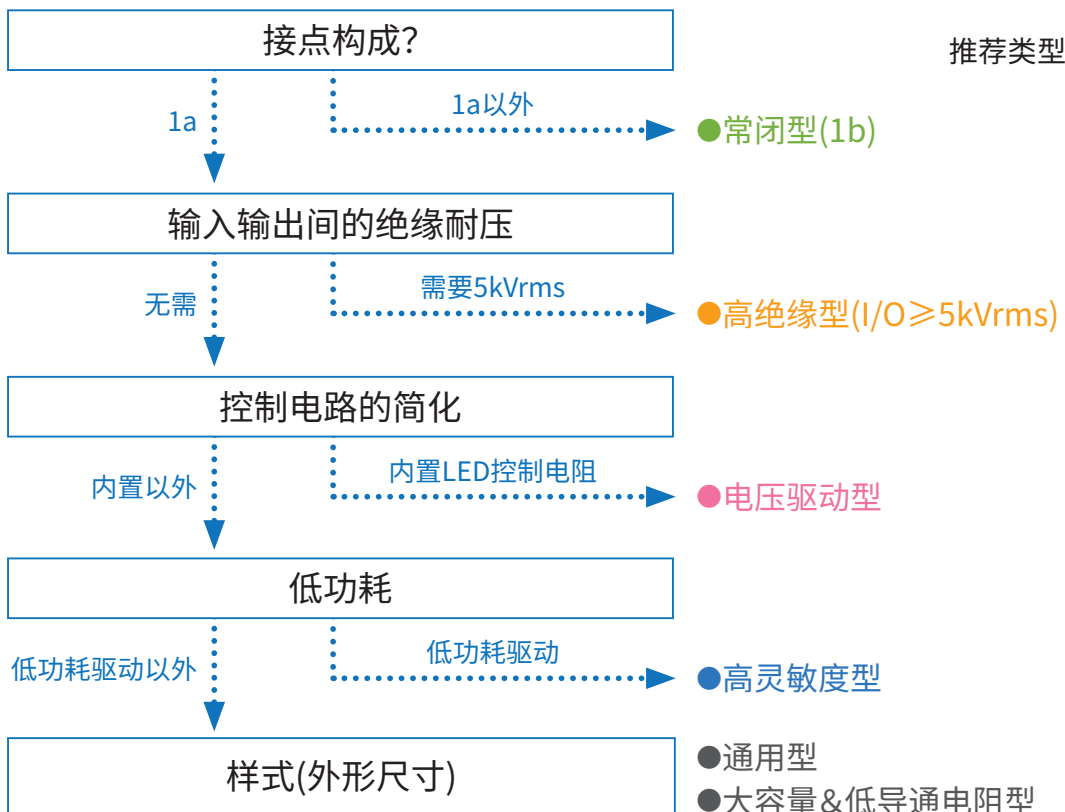
封装面积约1/4!

27.3mm²

7.1mm²



产品选型指南



各种封装 特性一览(卷末)

DIP	SOP	SSOP	USOP	P-SON	VSON(R)	VSON	S-VSON
假设封装面积为100%	封装面积 62%	封装面积 24%	封装面积 20%	封装面积 19%	封装面积 10%	封装面积 9%	封装面积 8% *相对于VSON为84%

MOS FET继电器 推荐产品系列

通用型

产品系列包括适用于各种用途的通用型, 以及常闭型(1b)

通用型

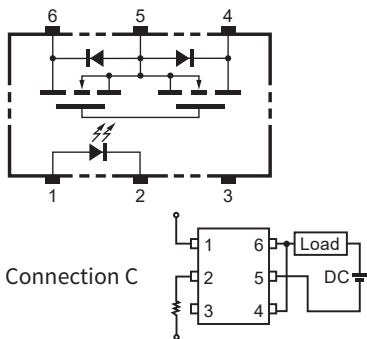
封装	型号规格	接点	负载电压 (V)	连续负载电流 (A)
SOP4	G3VM-41GR8	1a	40	1
SOP4	G3VM-41GR5	1a	40	0.30
SOP4特殊	G3VM-61VY2	1a	60	0.50
SOP4特殊	G3VM-61VY3	1a	60	0.70
SOP4特殊	G3VM-61VR	1a	60	1.40
SOP4	G3VM-201G1	1a	200	0.20
SOP4	G3VM-S5	1a	200	0.20
SOP4特殊	G3VM-351VY	1a	350	0.11
SOP4	G3VM-401G1	1a	400	0.10
SOP4特殊	G3VM-401VY	1a	400	0.11
SOP4	G3VM-401G	1a	400	0.12

常闭型

封装	型号规格	接点	负载电压 (V)	连续负载电流 (A)
SOP4	G3VM-63G	1b	60	0.50
NEW	DIP6	G3VM-63BR	1b	1.20
NEW	DIP6	G3VM-63ER	1b	1.20

大容量&低导通电阻型

可流经更大电流的型号。
有助于减少设备发热和损失。



封装	型号规格	接点	负载电压 (V)	连续负载电流 (A) *
DIP6	G3VM-31BR/ER	1a	30	5.0 (10)
DIP6	G3VM-61BR2/ER2	1a	60	4.0 (8)
DIP6	G3VM-101BR1/ER1	1a	100	3.5 (7)
SOP6	G3VM-31HR1	1a	30	4.5 (9)
SOP6	G3VM-61HR2	1a	60	4.0 (8)
SOP6	G3VM-101HR2	1a	100	3.0 (6)

* ()内为C连接下的值(仅限DC负载)

封装	型号规格	接点	负载电压 (V)	连续负载电流 (A)
DIP4	G3VM-31AR/DR	1a	30	4
DIP4	G3VM-61AR1/DR1	1a	60	3
DIP4	G3VM-101AR1/DR1	1a	100	2

MOS FET继电器 推荐产品系列

高绝缘型(I/O≥5kVrms)

高绝缘型MOS FET继电器, 面向输入输出间要求绝缘性能的应用

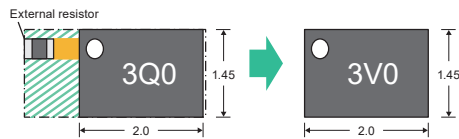
封装	型号规格	接点	负载电压(V)	连续负载电流(A)	使用环境温度(°C)	输入输出间耐压(Vrms)	
DIP4	G3VM-41AY1/DY1	1a	40	2	-40~85	5,000	
DIP4	G3VM-61AY1/DY1	1a	60	0.5	-40~85	5,000	
DIP4	G3VM-201AY1/DY1	1a	200	0.25	-40~85	5,000	
DIP4	G3VM-351AY1/DY1	1a	350	0.1	-40~85	5,000	
DIP4	G3VM-401AY1/DY1	1a	400	0.12	-40~85	5,000	
NEW	DIP4	G3VM-401AY2/DY2	1a	400	0.12	-40~110	5,000
DIP4	G3VM-601AY1/DY1	1a	600	0.09	-40~85	5,000	
NEW	DIP4	G3VM-601AY2/DY2	1a	600	0.09	-40~110	5,000

电压驱动型

电压驱动型MOS FET继电器, 面向要求小型的用途, 可以省去输入侧的电阻选型

S-VSON (existing)
Use with input current limiting resistor
Mounting area 2.90mm² + resistor area

S-VSON(L) voltage driven
Built-in input current limiting resistor
Mounting area 2.90mm²



封装	型号规格	接点	负载电压(V)	连续负载电流(A)	动作输入电压(V)
VSON(R)4	G3VM-21UV11	1a	20	1.0	≤5.0
VSON(R)4	G3VM-51UV	1a	50	0.3	≤5.0
VSON(R)4	G3VM-61UV	1a	60	0.4	≤5.0
S-VSON(L)4	G3VM-31QVH	1a	30	1.5	≤5.0
S-VSON(L)4	G3VM-31QVL	1a	30	1.5	≤2.5
S-VSON(L)4	G3VM-61QVH	1a	60	0.4	≤5.0
S-VSON(L)4	G3VM-61QV2H	1a	60	1.0	≤5.0
S-VSON(L)4	G3VM-61QV2L	1a	60	1.0	≤2.5

高灵敏度型

减小了ON动作所需的输入电流的高灵敏度型MOS FET继电器

封装	型号规格	接点	负载电压(V)	连续负载电流(A)	触发LED正向电流(标准)(mA)	触发LED正向电流(最大)(mA)	
SOP4	G3VM-61G2	1a	60	0.40	0.40	1.00	
SOP4	G3VM-61G3	1a	60	0.40	0.02	0.10	
NEW	SOP4特殊	G3VM-61VY4	1a	60	0.70	0.10	1.00
SOP4	G3VM-201G1	1a	200	0.20	0.40	1.00	
SOP4	G3VM-201G2	1a	200	0.20	0.02	0.10	
NEW	SOP4特殊	G3VM-351VY1	1a	350	0.11	0.20	1.00
SOP4	G3VM-401G1	1a	400	0.10	0.02	0.10	
SOP4	G3VM-601G	1a	600	0.09	0.40	1.00	
SOP4	G3VM-601G1	1a	600	0.07	0.02	0.10	

MOS FET继电器 产品系列INDEX

详细测量条件等请在WEB页面或各样本上进行确认。

DIP											
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)	
30	G3VM-31AR/DR	4	1a	4000	0.025	1000	450	3.0	1.0	2,500	★
30	G3VM-31BR/ER	6	1a	5000 (10000) *	0.02	1000	1100	5.0	0.5	2,500	★
40	G3VM-41AY1/DY1	4	1a	2000	0.09	1000	300	5.0	1.0	5,000	
60	G3VM-61AY1/DY1	4	1a	500	0.6	1000	130	3.0	1.0	5,000	
60	G3VM-61AR1/DR1	4	1a	3000	0.045	1000	250	2.0	1.0	2,500	★
60	G3VM-61BR2/ER2	6	1a	4000 (8000) *	0.035	1000	640	5.0	0.5	2,500	★
60	G3VM-61CR1/FR1	8	1a	5000 (10000) *	0.022	10000	850	5.0	1.0	2,500	
60	G3VM-63BR/ER	6	1b	1200 (2400) *	0.6	10	550	2.0	3.0	5,000	★
100	G3VM-101AR1/DR1	4	1a	2000	0.11	1000	110	2.0	0.5	2,500	★
100	G3VM-101BR1/ER1	6	1a	3500 (7000) *	0.05	1000	450	5.0	0.5	2,500	★
100	G3VM-101CR/FR	8	1a	3000 (6000) *	0.06	1000	720	5.0	1.0	2,500	
200	G3VM-201AY1/DY1	4	1a	250	5	1000	90	3.0	1.0	5,000	
200	G3VM-201AR/DR	4	1a	700	0.9	1000	110	1.0	0.5	2,500	★
200	G3VM-201CR/FR	8	1a	1500 (3000) *	0.25	1000	400	5.0	1.0	2,500	
350	G3VM-351AY1/DY1	4	1a	100	35	1000	30	2.0	1.0	5,000	
400	G3VM-401AY1/DY1	4	1a	120	22	1000	80	2.0	1.0	5,000	
400	G3VM-401AY2/DY2	4	1a	120	22	1000	80	1.0	0.5	5,000	★
400	G3VM-401CR/FR	8	1a	400 (800) *	3	1000	410	1.0	1.0	2,500	
600	G3VM-601AY1/DY1	4	1a	90	45	1000	75	2.0	1.0	5,000	
600	G3VM-601AY2/DY2	4	1a	90	45	1000	75	0.5	0.2	5,000	★
600	G3VM-601CR/FR	8	1a	600 (1200) *	1.3	10000	4300	3.0	1.0	2,500	

* ()内为C连接下的值(仅限DC负载)

注. 使用环境温度: ★-40~+110°C、◆-40~+105°C、○-20~+85°C, 其他为-40~+85°C

MOS FET继电器 产品系列INDEX

详细测量条件等请在WEB页面或各样本上进行确认。

SOP											
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)	
30	G3VM-31HR1	6	1a	4500 (9000) *1	0.022	1000	1200	2.0	0.5	1,500	★
40	G3VM-41GR6	4	1a	120	10	1	1	0.5	0.5	1,500	○
40	G3VM-41GR5	4	1a	300	1	1	10	0.5	0.5	1,500	
40	G3VM-41GR8	4	1a	1000	0.1	1	300	3.0	0.5	1,500	
60	G3VM-61VY1 *2	4	1a	100	25	1000	10	5.0	5.0	3,750	
60	G3VM-61G2	4	1a	400	1	1000	130	8.0	3.0	1,500	
60	G3VM-61G3	4	1a	400	1	1000	130	10.0	5.0	1,500	
60	G3VM-61VY2 *2	4	1a	500	1	1000	20	2.0	0.5	3,750	★
60	G3VM-61VY3 *2	4	1a	700	0.15	1000	100	3.0	0.5	3,750	★
60	G3VM-61VY4 *2	4	1a	700	0.15	1000	100	6.0	1.0	3,750	
60	G3VM-61VR *2	4	1a	1400	0.13	1000	100	3.0	1.0	3,750	★
60	G3VM-63G	4	1b	500	1	1000	100	1.0	3.0	1,500	◆
60	G3VM-61HR2	6	1a	4000 (8000) *1	0.028	1000	750	2.0	0.5	1,500	★
100	G3VM-101HR2	6	1a	3000 (6000) *1	0.05	1000	460	2.0	0.5	1,500	★
200	G3VM-201G1	4	1a	200	5	1000	90	8.0	3.0	1,500	
200	G3VM-201G2	4	1a	200	5	1000	90	10.0	5.0	1,500	
200	G3VM-S5	4	1a	200	5	1000	100	1.5	1.0	1,500	
350	G3VM-351VY *2	4	1a	110	35	1000	30	1.0	0.5	3,750	★
350	G3VM-351VY1 *2	4	1a	110	28	1000	30	2.0	1.0	3,750	
400	G3VM-401G1	4	1a	100	18	1000	70	10.0	5.0	1,500	
400	G3VM-401G	4	1a	120	17	1000	70	1.0	1.0	1,500	
400	G3VM-401VY *2	4	1a	110	40	1000	30	1.0	0.5	3,750	★
600	G3VM-601G1	4	1a	70	35	1000	75	10.0	5.0	1,500	
600	G3VM-601G	4	1a	90	45	1000	75	8.0	3.0	1,500	

*1. ()内为C连接下的值(仅限DC负载)

*2. VY1、VY2、VY3、VR型为SOP4针(特殊)封装

注. 使用环境温度: ★-40~+110°C、◆-40~+105°C、○-20~+85°C, 其他为-40~+85°C

MOS FET继电器 产品系列INDEX

详细测量条件等请在WEB页面或各样本上进行确认。

P-SON										
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA) *	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)
30	G3VM-31WR	4	1a	4500	0.025	10	450	5	1	500
60	G3VM-61WR	4	1a	3000	0.045	10	250	5	1	500
100	G3VM-101WR	4	1a	2000	0.13	10	170	3	1	500
200	G3VM-201WR	4	1a	350	4.5	10	75	1	1	500

* 测量条件请参阅产品样本

USOP										
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)
20	G3VM-21PR10	4	1a	200	3	1	0.8	0.2	0.2	500
20	G3VM-21PR1	4	1a	450	0.6	1	5	0.5	0.5	500
20	G3VM-21PR11	4	1a	900	0.18	1	40	2.0	1.0	500
40	G3VM-41PR12	4	1a	100	15	1	0.3	0.2	0.2	500
40	G3VM-41PR10	4	1a	120	12	1	0.45	0.2	0.3	500
40	G3VM-41PR6	4	1a	120	10	0.2	1	0.2	0.3	500
40	G3VM-41PR11	4	1a	140	7	1	0.7	0.2	0.2	500
40	G3VM-41PR5	4	1a	300	1	1	10	0.5	0.3	500
50	G3VM-51PR	4	1a	300	1	1	12	0.5	0.4	500
60	G3VM-61PR1	4	1a	120	10	1	0.7	0.2	0.2	500
60	G3VM-61PR	4	1a	400	1	1	20	0.5	0.5	500
75	G3VM-71PR	4	1a	400	1	1	30	2.0	1.0	500
80	G3VM-81PR	4	1a	120	7	0.02	5	0.5	0.2	500
100	G3VM-101PR	4	1a	100	8	0.2	6	0.3	0.3	500

注.使用环境温度:-40~+85°C

VSON(R)											
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	推荐动作输入正向电压(标准)(V)	输入输出间耐压 (Vrms)
20	G3VM-21UV11	4	1a	1000	0.18	1	40	2.0	1.0	5	500
50	G3VM-51UV	4	1a	300	1	1	12	0.5	0.4	5	500
60	G3VM-61UV	4	1a	400	1	1	20	0.5	0.5	5	500

注.使用环境温度:-40~+110°C

VSON										
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)
20	G3VM-21UR10	4	1a	200	3	1	0.8	0.2	0.2	500
20	G3VM-21UR1	4	1a	450	0.8	1	5	0.4	0.4	500
20	G3VM-21UR11	4	1a	1000	0.18	1	40	2.0	1.0	500
40	G3VM-41UR12	4	1a	100	15	1	0.3	0.2	0.2	500
40	G3VM-41UR10	4	1a	120	12	1	0.45	0.2	0.3	500
40	G3VM-41UR11	4	1a	140	5	1	0.7	0.2	0.2	500
40	G3VM-41UR4	4	1a	250	2	1	5.0	0.3	0.3	500
50	G3VM-51UR	4	1a	300	1	1	12	0.5	0.4	500
60	G3VM-61UR1	4	1a	120	10	1	0.7	0.2	0.2	500
60	G3VM-61UR	4	1a	400	1	1	20	0.5	0.5	500
80	G3VM-81UR	4	1a	120	7	0.02	5	0.5	0.2	500
80	G3VM-81UR1	4	1a	200	6	1	6.5	0.4	0.4	500
100	G3VM-101UR	4	1a	100	8	0.2	6	0.3	0.3	500

注.使用环境温度:-40~+110°C

S-VSON										
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	输入输出间耐压 (Vrms)
30	G3VM-31QR	4	1a	1500	0.1	1	120	2.0	1.0	500
40	G3VM-41QR10 *	4	1a	120	11	1	0.45	0.2	0.3	500
60	G3VM-61QR	4	1a	400	1.1	1	12	0.5	0.3	500
60	G3VM-61QR2	4	1a	1000	0.2	1	80	2.0	0.3	500
100	G3VM-101QR1	4	1a	650	0.4	1	50	2.0	0.3	500

* 41QR10型为S-VSON(L)矮型封装

注.使用环境温度:-40~+110°C

S-VSON											
负载电压 (最大)(V)	型号	端子数	接点构成	连续负载电流 (最大)(mA)	最大输出导通电阻 (标准)(Ω)	开路时漏电流 (最大)(nA)	端子间电容 (标准)(pF)	动作时间 (最大)(ms)	复位时间 (最大)(ms)	推荐动作输入正向电压(标准)(V)	输入输出间耐压 (Vrms)
30	G3VM-31QVH	4	1a	1500	0.1	1	120	2	0.2	5	500
30	G3VM-31QVL	4	1a	1500	0.1	1	120	2	0.2	2.5	500
60	G3VM-61QV2H	4	1a	1000	0.2	1	80	2	0.2	5	500
60	G3VM-61QV2L	4	1a	1000	0.2	1	80	1	0.2	2.5	500
60	G3VM-61QVH	4	1a	400	1	1	20(最大)	0.5	0.2	5	500

* S-VSON(L)矮型封装

注.使用环境温度:-40~+110°C

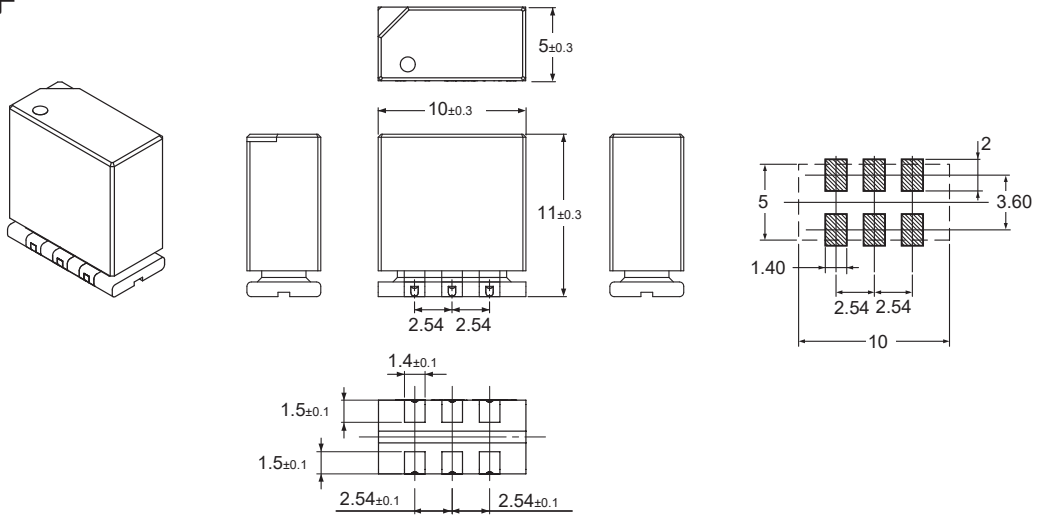
MOS FET继电器模组 封装外形尺寸图、外观示例

(单位:mm)

SPDT模组

表面安装端子

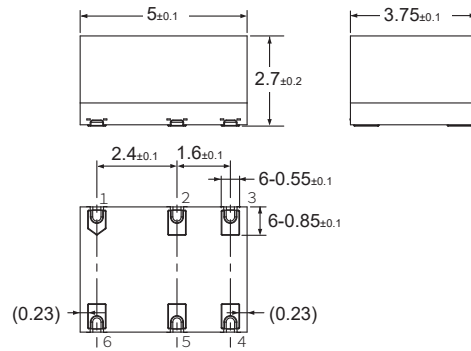
重量:1g



T-模组

表面安装端子

重量:0.11g



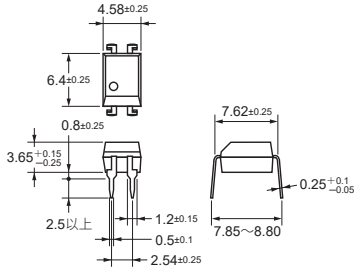
MOS FET继电器 封装外形尺寸图、外观示例

(单位:mm)

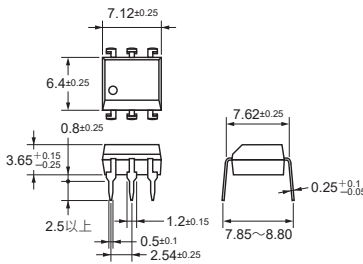
DIP(Dual Inline Package)

印刷电路板用端子

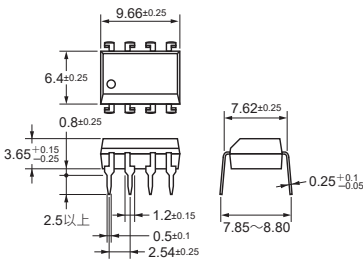
■DIP4针 重量: 0.25g



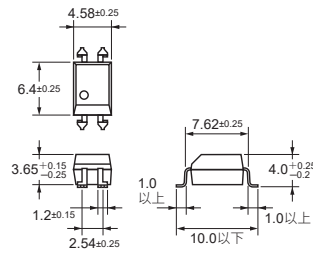
■DIP6针 重量: 0.4g



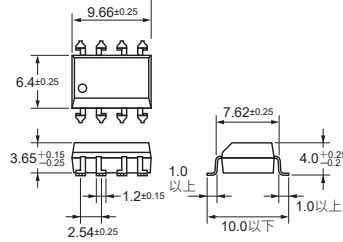
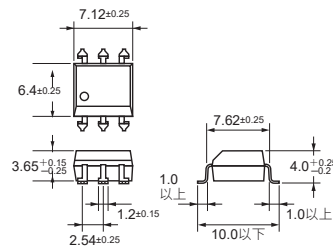
■DIP8针 重量: 0.54g



表面安装端子



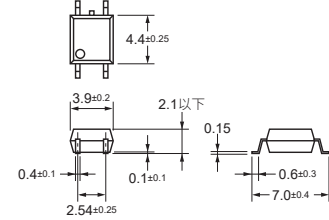
(G3VM-61BR/ER除外)



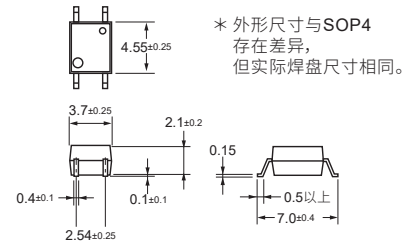
SOP(Small Outline Package)

表面安装端子

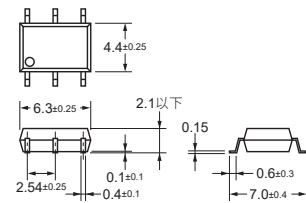
■SOP4针 重量: 0.1g



■SOP4针(特殊) 重量: 0.1g



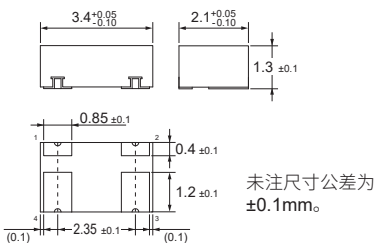
■SOP6针 重量: 0.13g



P-SON(Power Small Outline Non-leaded)

表面安装端子

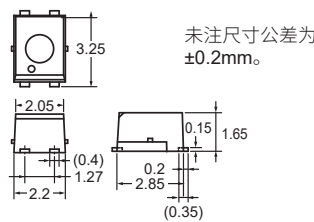
■P-SON4针 重量: 0.02g



USOP(Ultra Small Outline Package)

表面安装端子

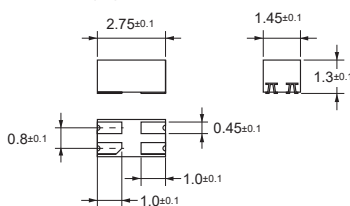
■USOP4针 重量: 0.03g



VSON(R)(Very Small Outline Non-Leaded with Resistor)

表面安装端子

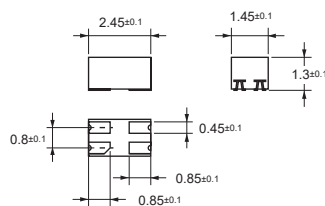
■VSON(R)4针 重量: 0.01g



VSON(Very Small Outline Non-leaded)

表面安装端子

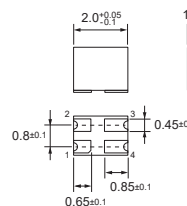
■VSON4针 重量: 0.01g



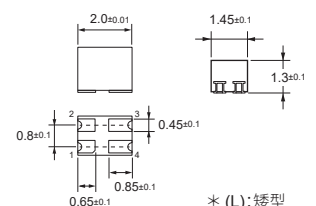
S-VSON(Super Very Small Outline Non-leaded)

表面安装端子

■S-VSON4针 重量: 0.01g



■S-VSON(L)*4针 重量: 0.01g



* (L): 矮型

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://components.omron.com.cn>

Cat. No. **SDBT-CN5-016T**

2024年1月

© OMRON Corporation 2022-2024 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。